

Germanium PNP Transistor

GD243

65V / 3A

DATASHEET

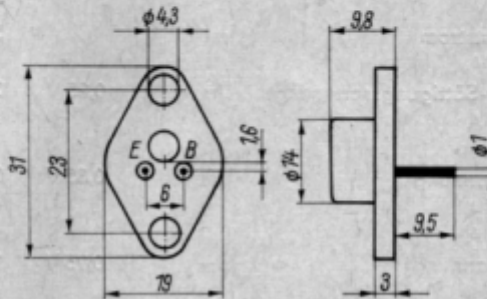
OEM – RFT

Source: RFT Datenbuch Germanium Transistoren 71/72



GD 243, 2-GD 243

Germanium-pnp-Leistungstransistor der Bauform D nach TGL 11 811 für Verstärker-Endstufen und als Paare für Gegentaktstufen im Niederfrequenzgebiet sowie für Schalteranwendungen bis 60 V.



Masse ca. 12 g

Grenzwerte


Kollektor-Basis-Spannung	$-U_{CB0}$	= 65 V
Kollektor-Emitter-Spannung	$-U_{CER}$	= 60 V
$R_{BE} = 50 \Omega$		
Kollektor-Emitter-Spannung	$-U_{CES}$	= 65 V
Emitter-Basis-Spannung	$-U_{EBO}$	= 20 V
Gesamtverlustleistung	P_{VL}	= 10 W
Kollektorstrom	$-I_{CL}$	= 3,0 A
Emitterstrom	I_{EL}	= 3,6 A
Basisstrom	$-I_{BL}$	= 0,6 A
Sperrschichttemperatur	θ_{jL}	= 85 °C
Umgebungstemperatur	θ_{aL}	= -25 °C bis +65 °C
Wärmewiderstand	R_{thjc}	≤ 4 grd/W



KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER)
Röhrenwerk Anna Seghers Neuhaus

133

GD 243, 2-GD 243




Statische Kennwerte		Min.	Typ	Max.	
Kollektor-Basis-Reststrom	$-I_{CBO}$		35 μ A	100 μ A	
$-U_{CB} = 6$ V					
Kollektor-Emitter-Reststrom	$-I_{CEV}$		0,06 mA	1 mA	
$-U_{CE} = 30$ V					
$U_{BE} = 1$ V					
Kollektor-Emitter-Reststrom	$-I_{CES}$		0,5 mA	2,5 mA	
$-U_{CE} = 65$ V					
Emitter-Basis-Reststrom	$-I_{EBO}$		50 μ A	500 μ A	
$-U_{CE} = 20$ V					
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung	$-U_{CEsat}$	0,25 V	0,6 V		
$-I_B = 0,5$ A					
$-I_C = 3$ A					
Basis-Emitter-Spannung	$-U_{BE}$	0,35 V	0,7 V		
$-U_{CE} = 6$ V					
$I_C = 0,5$ A					
Basis-Emitter-Spannung	$-U_{BE}$	0,75 V	1,4 V		
$-U_{CE} = 2$ V					
$-I_C = 2$ A					
Dynamische Kennwerte					
Übergangsfrequenz	f_T	300 kHz			
$-U_{CE} = 6$ V					
$-I_C = 0,1$ A					
Kurzschlußstromverstärkung	h_{21E}	18		35	A
$-U_{CE} = 2$ V		28		56	B
$-I_C = 2$ A		45		90	C
Kurzschlußstromverstärkung	h_{21E}	40			
$-U_{CE} = 6$ V					
$-I_C = 0,5$ A					
h_{21E} -Verhältnis	$\frac{h_{21E 2,0}}{h_{21E 0,5}}$	0,5			
$-U_{CE} = 2$ V					
$-I_C = 2$ A					
$-I_C = 0,5$ A					

134

KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER)

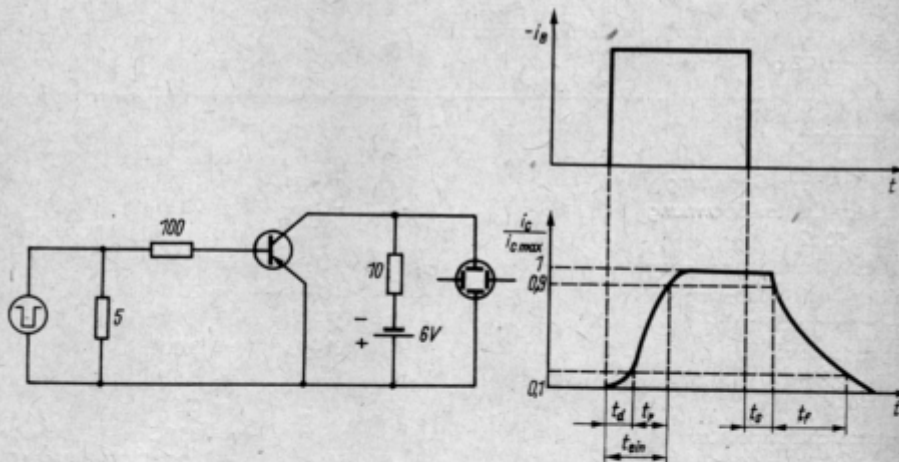
Röhrenwerk Anna Seghers Neuhaus





GD 243, 2-GD 243

	Min.	Typ	Max.
Pärchenbedingungen			
$I_{B1} : -U_{CE} = 6\text{ V}$ $-I_C = 0,5\text{ A}$			1,2
$I_{B2} : -U_{CE} = 2\text{ V}$ $-I_C = 3\text{ A}$			
$-U_{CE} = 2\text{ V}$ $-I_C = 3\text{ A}$			1,2
Schaltzeiten	t_{on}	22 μs	44 μs
Siehe Meßschaltung	t_s	5 μs	10 μs
Übersteuerungsfaktor $m = 3$	t_f	7 μs	14 μs



Bestellbeispiel für einen Transistor
der Stromverstärkungsgruppe A

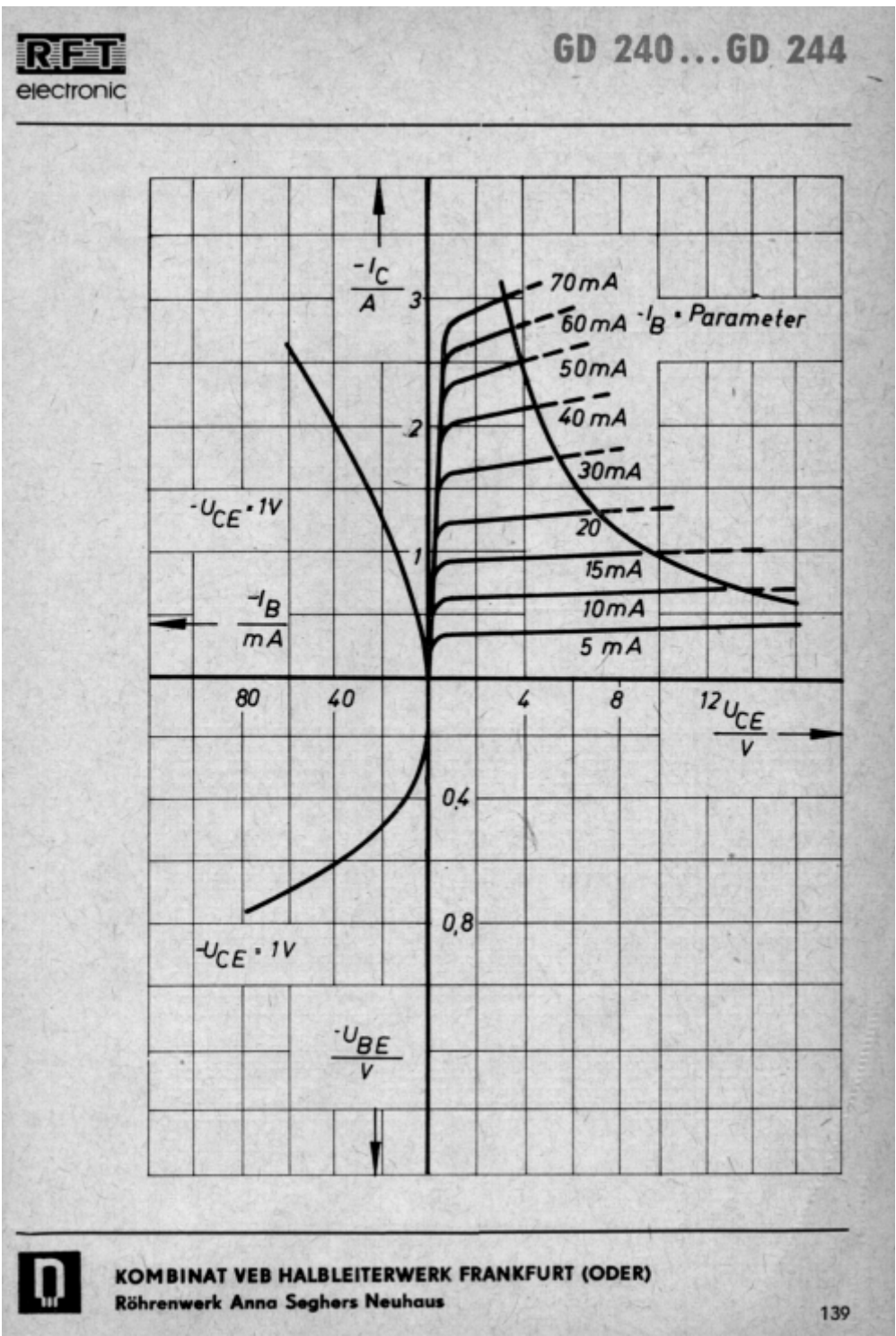
Transistor GD 243 A

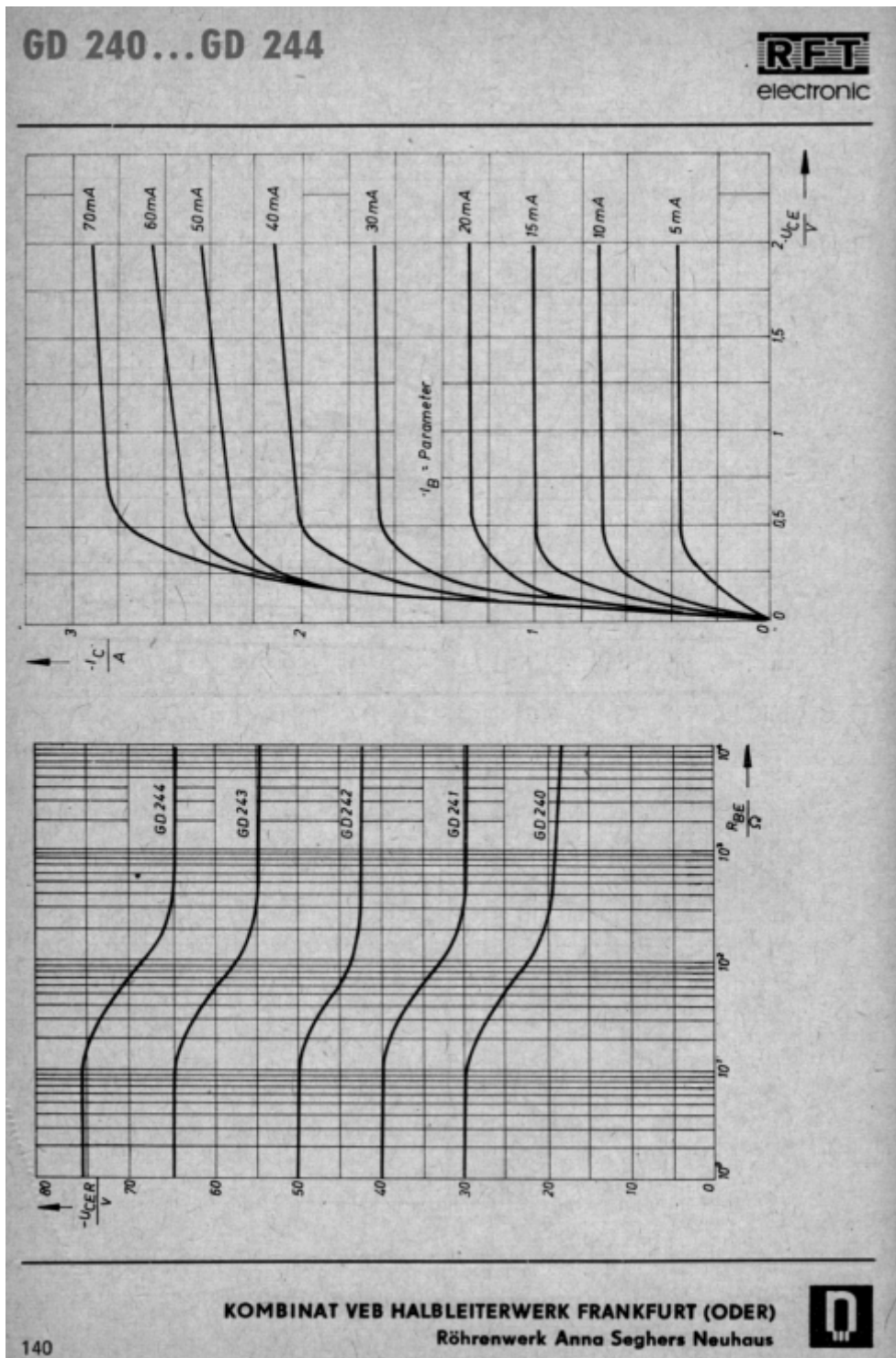
Bestellbeispiel für ein Transistorpaar
der Stromverstärkungsgruppe A

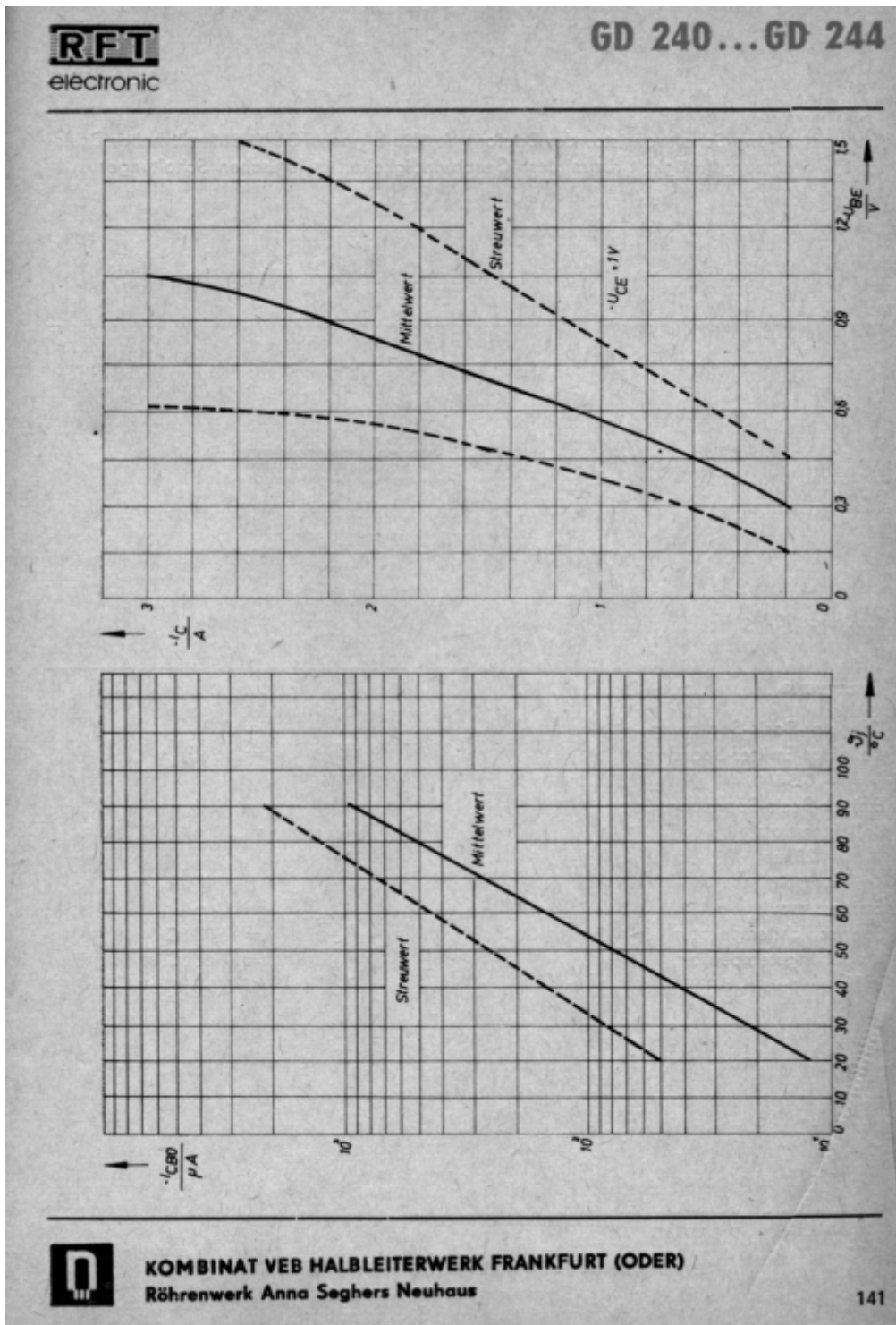
Transistorpaar 2-GD 243 A



KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER)
Röhrenwerk Anna Seghers Neuhaus







KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER)
Röhrenwerk Anna Seghers Neuhaus